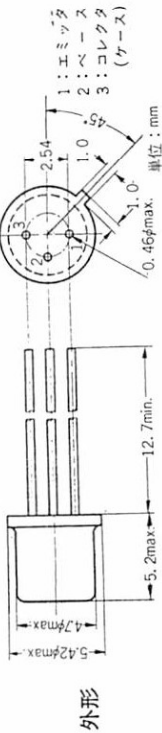


シリコン NPN エピタキシャル  
プレナ形  
高周波増幅, スイッチング用

# 2SC427 2SC428



特性図については 2SC423 の項をご参照ください。 \* ( ) 内は 2SC428

I. 最大定格 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

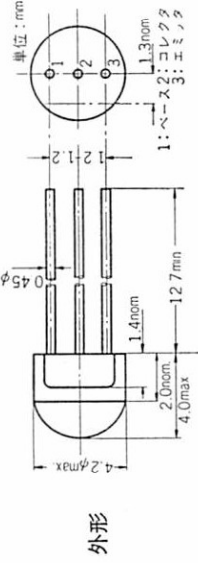
コレクタ・ベース電圧 $V_{CB0}$	40 (20)* V
エミッタ・ベース電圧 $V_{EB0}$	5 V
コレクタ電流 $I_C$	100 mA
コレクタ損失 $P_C$	300 mW
接合部温度 $T_j$	175 $^\circ\text{C}$
保存温度 $T_{stg}$	-65 ~ +175 $^\circ\text{C}$

II. 電気的特性 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

コレクタ遮断電流 $I_{CB0}$	1 $\mu\text{A}$	最小	標準	最大
エミッタ遮断電流 $I_{EB0}$	1 $\mu\text{A}$			
直流電流増幅率 $h_{FE}$	80			
利得帯域幅積 $f_T$	180 MHz			
出力容量 $C_{ob}$	5 pF			

シリコン NPN プレナ形  
低周波小信号増幅,  
AM, FM 中間周波増幅用

# 2SC536 2SC537



I. 最大定格 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ ) \* ( ) 内は 2SC537

コレクタ・ベース電圧 $V_{CB0}$	40 (20)* V
エミッタ・ベース電圧 $V_{EB0}$	5 V
コレクタ電流 $I_C$	100 mA
コレクタ損失 $P_C$	200 mW
接合部温度 $T_j$	125 $^\circ\text{C}$
保存温度 $T_{stg}$	-40 ~ +125 $^\circ\text{C}$

II. 電気的特性 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

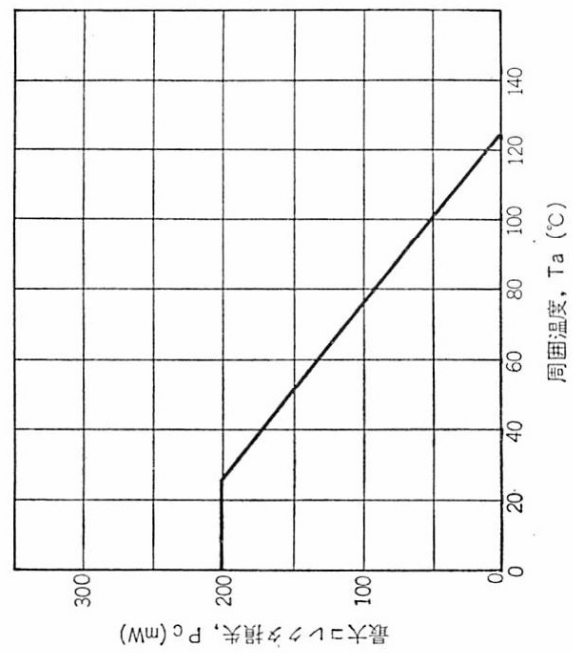
コレクタ遮断電流 $I_{CB0}$	1 $\mu\text{A}$	最小	標準	最大
エミッタ遮断電流 $I_{EB0}$	1 $\mu\text{A}$			
直流電流増幅率 $h_{FE}$	120			
利得帯域幅積 $f_T$	180 MHz			
出力容量 $C_{ob}$	3 pF			
ベース・コレクタ時間定数 $\tau_{bb}C_c$	250 ps			
y パラメータ ( $V_{CE} = 6\text{V}, I_C = 2\text{mA}$ )	455 kHz	10.7 MHz		
並列入力抵抗 $r_{ie}$	22 $\text{k}\Omega$	0.85 $\text{k}\Omega$		
並列入力容量 $c_{ie}$	21 pF	26 pF		
逆伝達遅延時間 $ y_{re} $	0.01 mS	0.24 mS		
逆伝達位相角 $\phi_{re}$	270 deg	260 deg		
順伝達遅延時間 $ y_{fe} $	62 ns	45 ns		
順伝達位相角 $\phi_{fe}$	360 deg	340 deg		

2SC536, 2SC537

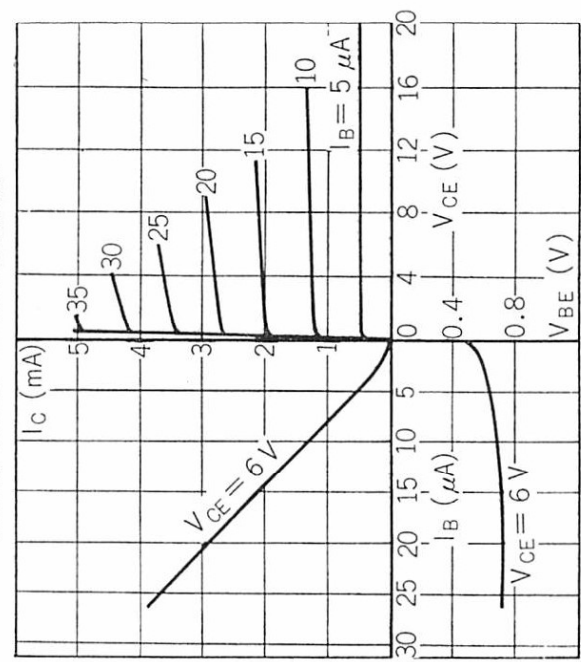
並列出力抵抗	$I_{oe}$ .....	45	2.2	$k\Omega$
並列出力容量	$C_{oe}$ .....	23	12	$pF$

2SC536, 2SC537

2SC536, 2SC537 最大コレクタ損失の周囲温度による変化

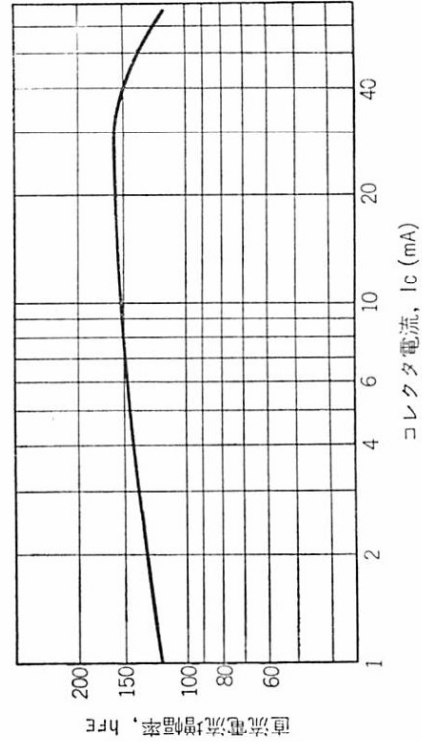


2SC536, 2SC537 エミッタ接地静特性



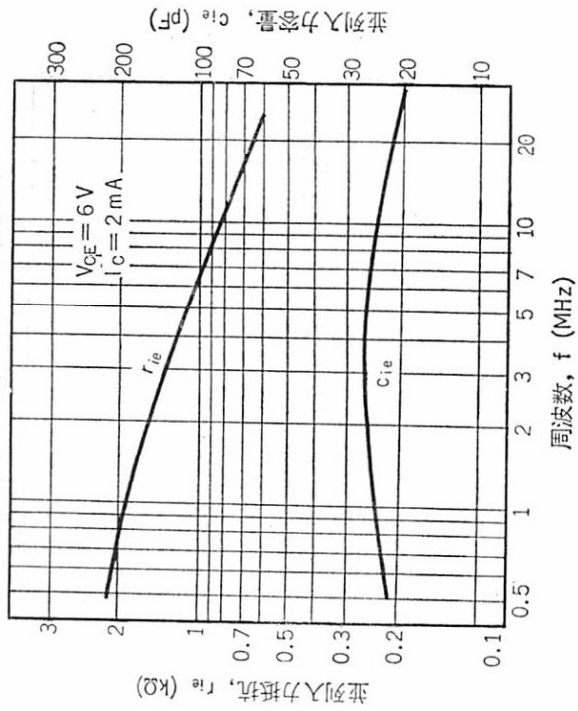
(346)

2SC536, 2SC537 電流増幅率の電流特性

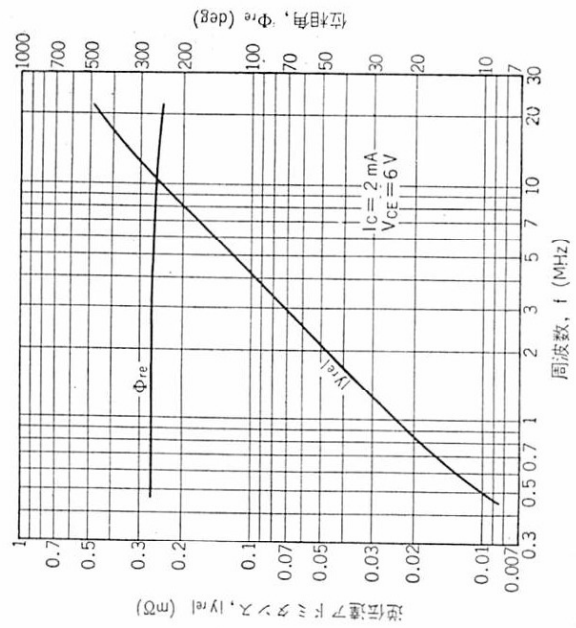


(347)

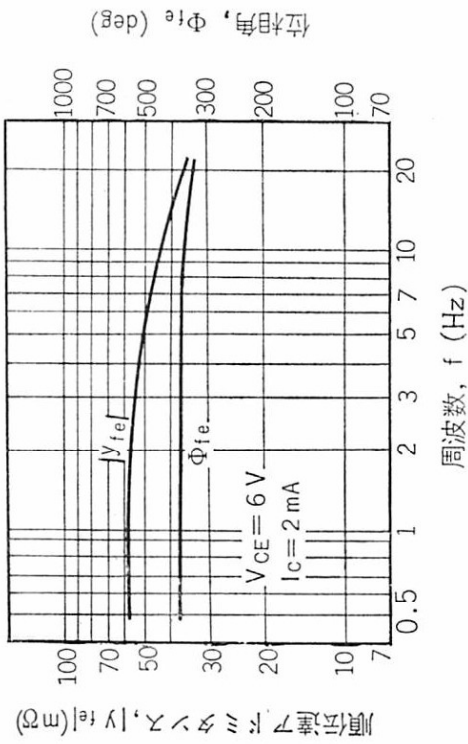
2SC536, 2SC537  $y_{re}$  の周波数特性



2SC536, 2SC537  $y_{re}$  の周波数特性



2SC536, 2SC537  $y_{re}$  の周波数特性



2SC536, 2SC537  $y_{oe}$  の周波数特性

